04:10

О влиянии продольного магнитного поля в ускоряющем промежутке на предельные параметры плазменного источника электронов в форвакуумной области давлений

© И.С. Жирков, В.А. Бурдовицин, Е.М. Окс

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 634050 Томск, Россия e-mail: burdov@fet.tusur.ru

(Поступило в Редакцию 11 ноября 2006 г.)

Представлены результаты исследований особенностей влияния продольного магнитного поля в ускоряющем промежутке на ток эмиссии, ускоряющее напряжение и максимальное рабочее давление газа для плазменного источника электронов, генерирующего непрерывный электронный пучок в форвакуумном диапазоне давлений. Показано, что создание магнитного поля в области формирования электронного пучка обусловливает стабилизацию эмиссионной границы плазмы, проникающей в ускоряющий промежуток, и таким образом обеспечивает существенное улучшение параметров источника электронов.

PACS: 52.50.Dg

Введение

Источники электронов с плазменным катодом на основе безнакальных разрядных систем обеспечивают эффективную генерацию электронных пучков в интервале давлений от высокого вакуума до так называемого форвакуумного диапазона $(1-10 \, \mathrm{Pa})$ [1,2]. Возможность получения ускоренных электронов при столь высоких давлениях является принципиальной особенностью устройств такого типа, которая с точки зрения генерации стационарных электронных пучков не имеет реальной альтернативы. Расширение рабочего диапазона плазменных источников электронов в область повышенных давлений обусловливает необходимость решения в первую очередь проблемы обеспечения электрической прочности ускоряющего промежутка. В проведенных ранее исследованиях было показано, что при генерации электронных пучков в форвакуумном диапазоне давлений наряду с наиболее часто возникающим межэлектродным пробоем ускоряющего промежутка может иметь место и так называемый "плазменный пробой", который связан с проникновением плазмы из разрядной области в ускоряющий промежуток и последующим замыканием ("переключением") разрядного тока с анода на ускоряющий электрод [3]. Эффект "переключения" разрядного тока достаточно тщательно изучен Жариновым с сотрудниками [4,5]. Эмиссионные параметры плазменного катода в условиях полного "переключения" тока являются, очевидно, предельными для режима его устойчивого функционирования. Небольшое превышение этих предельных параметров и приводит к "плазменному" пробою.

Как было показано в работах [4,5], решающим фактором для подобного "переключения" является достижение площадью электронного коллектора, а в нашем случае эмиссионной поверхности плазмы, некоторого

предельного значения, при котором величина хаотического тока электронов из плазмы сравнивается с током разряда. Это обстоятельство указывает на возможность обеспечения требуемой электрической прочности ускоряющего промежутка за счет ограничения площади эмитирующей поверхности плазмы, которое может быть реализовано, например, за счет создания в области отбора и ускорения электронов продольного магнитного поля. Такой метод известен и широко используется в так называемых диодах с магнитной изоляцией для генерации нестационарных сильноточных электронных и ионных пучков [6].

Цель настоящей работы состояла в исследовании особенностей влияния продольного магнитного поля на предельные параметры плазменного источника электронов, генерирующего непрерывный электронный пучок в форвакуумном диапазоне давлений.

1. Техника эксперимента

В экспериментах использовался плазменный источник электронов на основе разряда с полым катодом, генерирующий узкосфокусированный электронный пучок в форвакуумной области давлений. Конструкция источника и принцип его работы были подробно описаны в [17]. В эксперименте реализованы следующие основные параметры источника: режим работы непрерывный, область рабочих давлений газа 1-10 Ра, ток разряда 0.1-1 А, ток пучка 30-100 mA, ускоряющее напряжение 5-15 kV.

Схема разрядно-эмиссионного узла, поясняющая одновременно сущность эксперимента и предложенную физическую модель, представлена на рис. 1. Разрядная система образована полым катодом I с выходной апертурой диаметром $D=8\,\mathrm{mm}$ и плоским анодом 2 с эмиссионным отверстием в центре диаметром $d=1.2\,\mathrm{mm}$. Ускоряющий электрод 3 расположен на

8* 115

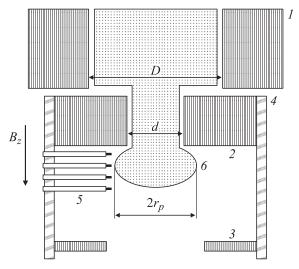


Рис. 1. Схема разрядно-эмиссионной системы электронного источника.

расстоянии 5-7 mm от анода и электрически отделен от него изолятором 4, выполненным из прозрачного стекла для обеспечения возможности визуальных наблюдений. Плазма 6 проникает через эмиссионное отверстие в аноде в ускоряющий промежуток и образует в нем эмиссионную поверхность радиусом r_p . Для определения параметров проникающей плазмы использованы 16 одиночных ленгмюровских зондов 5, изготовленных из фольфрамовой проволоки диаметром 0.4 mm, введенных в промежуток сквозь стенку изолятора. Концентрация плазмы определялась по ионной ветви тока насыщения зонда. Для измерения потенциала плазмы в эмиссионный канал вводился термозонд со стороны ускоряющего промежутка. Потенциал был измерен относительно анода и определялся по точке расхождения вольт-амперных характеристик накаленного и холодного зондов. Аксиальное магнитное поле с индукцией $B_z = 0 - 15 \,\mathrm{mT}$ создавалось соленоидом, охватывающим разрядно-эмиссионную систему.

При работе плазменного источника электронов в форвакуумной области давлений практически невозможно создать перепад давлений между областями генерации плазмы и ускорения электронного пучка. Поэтому эксперименты проводились без напуска газа в катодную полость. При необходимости повышения давления газа (воздух) подавался непосредственно в вакуумную камеру.

2. Результаты эксперимента

Как показали результаты измерений, увеличение индукции аксиального магнитного поля заметно снижает потенциал плазмы на оси системы непосредственно возле эмиссионного отверстия в аноде (рис. 2,a). Концентрация плазмы возрастает в области относительно малых значений индукции магнитного поля, выходя

затем на насыщение (рис. 2, b). Результаты измерений распределения плотности плазмы, проникающей через эмиссионное отверстие в ускоряющий промежуток, свидетельствуют о том, что магнитное поле препятствует радиальному распространению плазмы, удерживая ее вблизи оси системы. Они совпадают с результатами аналогичных измерений, проведенных в [8] с плазменным ионным источником и в целом соответствуют современным представлениям о поведении плазмы в магнитном поле. Значения распределений, приведенные на рис. 3, были сняты в отсутствие напряжения на ускоряющем промежутке. Вместе с тем визуальные наблюдения показали, что с подачей ускоряющего напряжения свечение проникающей плазмы становится более ярким и диаметр светящейся области увеличивается, это может свидетельствовать об усилении интенсивности ионизационных процессов. Включение напряжения на

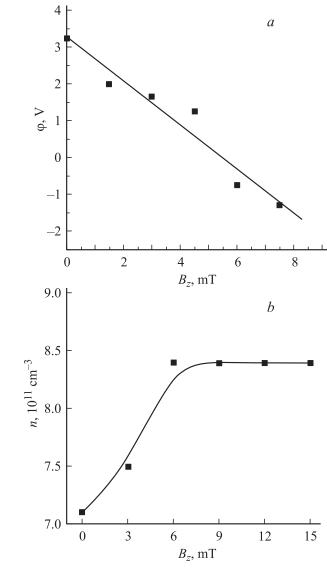


Рис. 2. Потенциал φ (*a*) и концентрация (*b*) *n* плазмы на выходе эмиссионного канала в зависимости от величины индукции магнитного поля. Ток разряда 400 mA; давление 5 Pa.

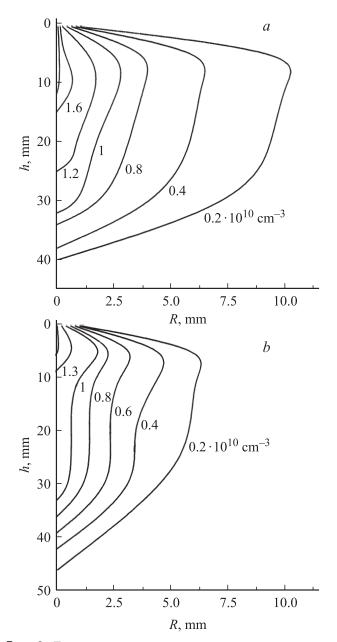


Рис. 3. Линии равной концентрации для плазмы, проникающей сквозь эмиссионное отверстие в ускоряющий промежуток в аксиальной h и радиальной r координатах для различных магнитных полей (a-4, $b-15\,\mathrm{mT}$). Давление газа $P=6\,\mathrm{Pa}$; разрядный ток $I_D=300\,\mathrm{mA}$.

ускоряющий промежуток приводило к появлению электронного пучка, величина тока I_b которого, измеренная на заземленном коллекторе, расположенном за пределами ускоряющего промежутка, возрастала с увеличением давления (рис. 4).

Однако при превышении давлением газа некоторого порогового значения наблюдалось резкое исчезновение пучка, сопровождавшееся появлением яркого свечения в ускоряющем промежутке. Исчезновение пучка происходило одновременно с падением напряжения на уско-

ряющем промежутке и скачком тока в цепи источника питания. Все это позволяет считать отмеченные эффекты пробоем промежутка. Как видно из рис. 4, величина предельного давления, при котором срывалась генерация электронного пучка, возрастала с увеличением индукции магнитного поля. Минимальная индукция магнитного поля, предотвращающая пробой промежутка, увеличивалась также и с ростом разрядного тока (рис. 5), т.е. с возрастанием концентрации плазмы (рис. 2, b). Наблюдаемое визуально свечение плазмы в пределах ускоряющего промежутка позволяет прийти к выводу о том, что магнитное поле оказывает влияние именно на проникающую плазму в большей степени, нежели на распространяющийся электронный пучок.

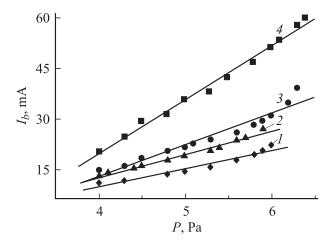


Рис. 4. Ток электронного пучка I_b как функция давления газа P для различных магнитных полей. I-1, 2-5.3, 3-7, $4-10\,\mathrm{mT}$. Диаметр эмиссионного отверстия $d=1.2\,\mathrm{mm}$; ускоряющее напряжение $U_a=1\,\mathrm{kV}$; ток разряда $400\,\mathrm{mA}$.

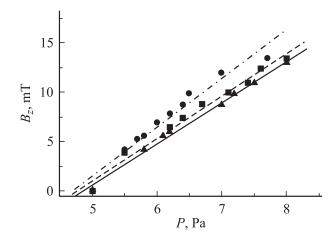


Рис. 5. Минимальная индукция B_z магнитного поля, предотвращающая пробой, как функция давления газа P для различных разрядных токов I_D : \blacktriangle — 500, \blacksquare — 600, \bullet — 700 mA. Диаметр эмиссионного отверстия d=1.2 mm; ускоряющее напряжение $U_a=1$ kV.

3. Обсуждение результатов эксперимента

Как указывалось выше, наблюдаемый в наших экспериментах плазменный механизм пробоя ускоряющего промежутка может быть обусловлен проникновением плазмы из разрядной области в ускоряющий промежуток и последующим переключением тока разряда с анода на ускоряющий электрод. Известно, что условие такого переключения выражается соотношением [4]

$$fG \ge 1. \tag{1}$$

Величина $f=(S_e/S_e+S_a)$ представляет собой отношение площади эмиссионной плазменной границы S_e к сумме площадей анода S_a и S_e . С учетом реальной конфигурации электродов (рис. 1) сумма S_a+S_e фактически равна поперечному сечению катодной полости $\pi D^2/4$, поскольку этим сечением определяется рабочая область анода, а S_e есть не что иное, как площадь эмиссионной границы плазмы πr_p^2 . Фактор G есть отношение плотности хаотического электронного тока в плазме j_c к плотности анодного тока j:

$$G = \frac{j_c}{i} = \exp\left(\frac{e(\varphi_p - \varphi_a)}{kT}\right),\tag{2}$$

где φ_p, φ_a — потенциалы плазмы и анода.

Выражение (1) показывает, что токовое переключение имеет место, если площадь плазменной эмиссионной границы становится больше некоторой критической величины. Поскольку радиальное распространение плазмы, проникающей в ускоряющий промежуток, ограничивается продольным магнитным полем, это позволяет установить связь между индукцией магнитного поля, плотностью плазмы и площадью ее границы, а следовательно, и условием переключения. Физическая модель, положенная в основу описания поведения плазмы, проникающей в ускоряющий промежуток через эмиссионное отверстие в аноде, содержит ряд допущений, справедливость которых обусловлена экспериментом. Плазма однородна в осевом направлении. Концентрация плазмы на оси задается параметрами разряда с полым катодом, в частности разрядным током. Радиальное распространение плазмы обусловлено амбиполярной диффузией. Генерация ионно-электронных пар осуществляется плазменными электронами. Ионы могут покидать плазму в осевом направлении на анод, а электроны — в эмиссию. Расчет радиального распределения концентрации плазмы может быть проведен на основе решения уравнения непрерывности для радиального потока частиц. Поскольку, как правило, поведение плазмы определяется ее более тяжелым и медленным ионным компонентом, то достаточно рассмотреть уравнение для ионов, в цилиндрических координатах оно выглядит следующим образом:

$$D_{\perp} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dn}{dr} \right) = -W_i + \frac{nv_i}{l}. \tag{3}$$

Здесь n — концентрация плазмы, W_i — интенсивность генерации ионов плазменными электронами, т. е. число актов ионизации в единице объема в единицу времени, nv_i/l — интенсивность исчезновения ионов вследствие их ухода на анод, v_i — бомовская скорость, l — протяженность плазмы в осевом направлении, D_{\perp} — коэффициент поперечной диффузии ионов в магнитном поле, представляемый выражением

$$D_{\perp} = \frac{D_0}{1 + (\lambda_i \lambda_e / r_i r_e)},\tag{4}$$

где D_0 — коэффициент амбиполярной диффузии без магнитного поля; λ_i , λ_e — длина свободного пробега ионов и электронов, r_i , r_e — их циклотронные радиусы. В случае линейной аппроксимации сечения ионизации от энергии электронов выражение для W_i имеет вид

$$W_i = n_n \left(\frac{8kT_e}{\pi m}\right)^{1/2} \alpha_i \exp\left(-\frac{e\varphi_i}{kT_e}\right) \left(\varphi_i + \frac{2kT_e}{e}\right) n, \quad (5)$$

где n_n и φ_i — концентрация нейтралей и потенциал ионизации, n и T_e — электронная концентрация и температура, α_i — коэффициент в линейной аппроксимации. Понятно, что для определения l требуется вычислять толщину слоя пространственного заряда, отделяющего плазму от ускоряющего электрода, и рассчитывать l как малую разность двух больших величин: межэлектродного расстояния и толщины слоя. Поскольку точность таких вычислений невелика, то в расчетах l была принята постоянной величиной, равной l mm, с учетом того, что диаметр эмиссионного отверстия имеет тот же порядок величины.

Уравнение (3) позволяет рассчитать r_p . Подстановка r_p в (1) дает возможность связать плотность плазмы на оси системы и необходимое магнитное поле. Результаты расчетов, представленные на рис. 6, оказываются в качественном соответствии с экспериментальными зависимостями, что свидетельствует в пользу предложенного

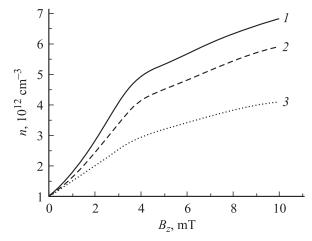


Рис. 6. Расчетные зависимости предельного значения n концентрации плазмы на оси системы от индукции аксиального магнитного поля B_{τ} : 1-3, 2-6, 3-9 Pa.

механизма влияния магнитного поля на предельные параметры плазменного источника электронов.

Заключение

Продольное магнитное поле в ускоряющем промежутке плазменного электронного источника позволяет предотвратить пробой и повысить предельные значения эмиссионного тока и давления газа. Физическая причина отмеченного эффекта заключается в удержании на оси системы плазмы, проникающей из разрядной области в ускоряющий промежуток, и ограничении площади ее эмитирующей поверхности. Это обстоятельство предотвращает переключение разряда с анода на ускоряющий электрод и, следовательно, скачкообразное возрастание тока и падение напряжения на ускоряющем промежутке.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 05-08-013119-а, а также ассоциации ИНТАС, грант 06-1000016-6254.

Список литературы

- [1] *Бурдовицин В.А., Бурачевский Ю.А., Окс Е.М.* и др. // Изв. вузов Физика. 2001, Т. 44. № 9. С. 85–89.
- [2] Бурдовицин В.А., Бурачевский Ю.А., Окс Е.М. // ЖТФ. 2001. Т. 71. Вып. 2. С. 48–50.
- [3] Бурдовицин В.А., Куземченко М.Н., Окс Е.М. // ЖТФ. 2002.Т. 72. Вып. 7. С. 134–136.
- [4] Жаринов А.В., Коваленко Ю.А. // ЖФТ. 1986. Т. 56. В. 4. С. 681–686.
- [5] Жаринов А.В., Коваленко Ю.А. // Изв. вузов. Физика. 2001. Т. 44. № 9. С. 44–47.
- [6] Агафонов А.В., Тараканов В.П., Федоров В.М. // ЖТФ. 2004. Т. 74. В. 1. С. 93–103.
- [7] *Бурдовицин В.А., Жирков И.С., Окс Е.М.* и др. // ПТЭ. 2005. № 6. С. 66–68.